



Phoenix G2.5 ALD
生产型原子层沉积系统

功能特点:

- ※ 批量生产型原子层沉积系统
- ※ 简洁易操作上下片接口
- ※ 预装包括二维材料的各种膜层工艺配方
- ※ 大尺寸沉积室，基片尺寸可达 2.5 代面板尺寸
- ※ 内置安全手套箱接口

应用领域:

※ 芯片封装、半导体 High-k 介电层、纳米涂层、3D 涂层、锂电池、催化剂、太阳能电池、
生物医学仿生、荧光材料、OLED 显示、有机材料、电子电路、光学膜等。



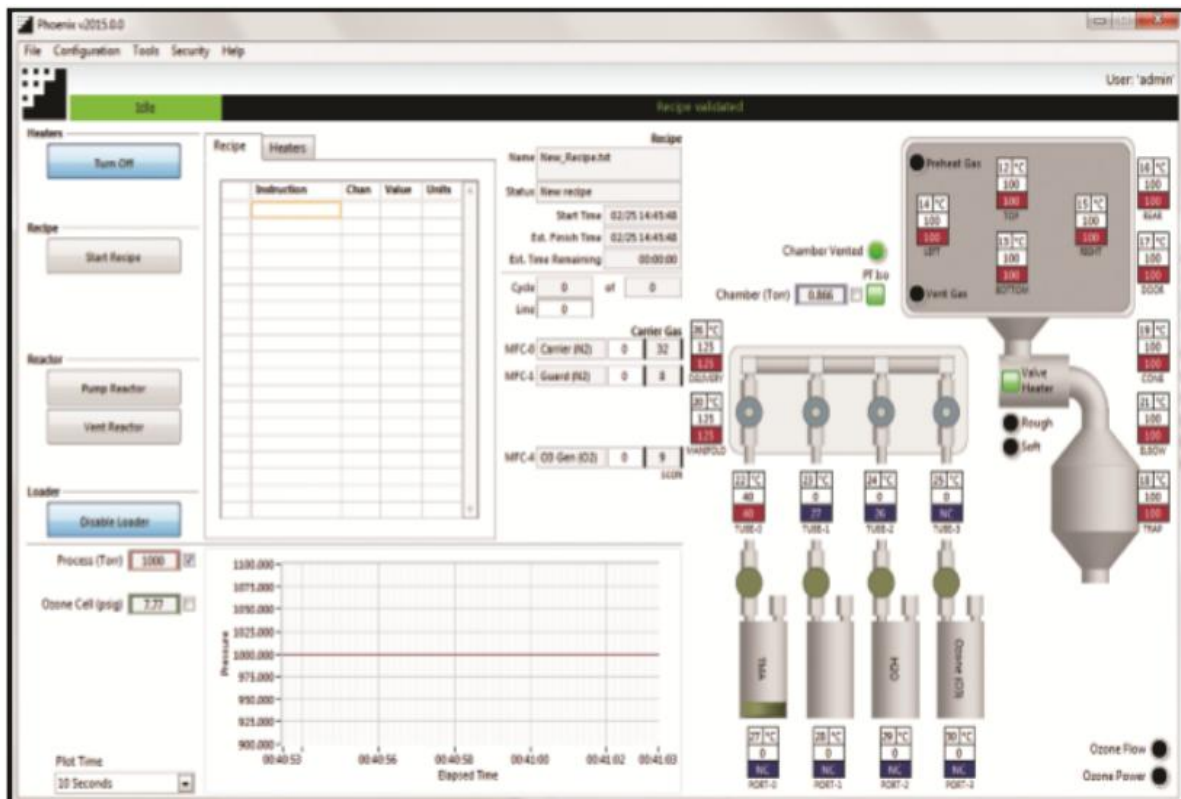
系统参数:	
基片尺寸	最大 370mm×470mm (G2.5 面板)
	100 wafers - 100 mm (cassette)
	100 wafers - 150 mm (cassette)
	100 wafers - 200 mm (cassette)
	25 wafers - 300 mm (cassette)
	对于其他 3D 工件可以定制
基片温度	可加热 285°C
沉积均匀性 (Al ₂ O ₃)	<2%
沉积室容积 (W x D x H)	500 mm x 400 mm x 240 mm
前驱通道	标配 4 路, 可扩展至 6 路, 每路均可通固、液、气前驱物, 各路均可独立加热至 200°C
	工业级 ALD 专用快速阀门, 响应时间 10ms
	钢瓶容积 3.1L 或 600ml
运载气体	N ₂ 气或 Ar 气, MFC 控制
真空泵	干泵, ≥350CFM
工作电源	208VAC, 3 相, 8500W (不含泵)
操作系统	Windows™ PC
机柜	排气柜装有烟雾报警器
外观尺寸 (W x D x H)	900 mm x 1370 mm x 1700 mm
兼容性	100 级洁净室
质量认证	CE, TUV, FCC
系统选配	Ozone Generator (200L/g)
	Glove Box Interface
	LVPD
	Semi-Automatic or Automated Loader
	SECS/GEM 跟主机通讯接口



可沉积膜层:

膜层分类	膜层材料
氧化物	Al ₂ O ₃ , HfO, La ₂ O ₃ , SiO ₂ , TiO ₂ , ZnO, ZrO ₂ , Ta ₂ O, In ₂ O ₃ , SnO ₂ , Fe ₂ O ₃ , MnO _x , Nb ₂ O ₅ , MgO, Er ₂ O ₃ , WO _x , MoO ₃ , V ₂ O ₃ , CeO _x
氮化物	WN, Hf ₃ N ₄ , Zr ₃ N ₄ , AlN, TiN, NbN _x , TaN, CoN, SiN, MnN, NbTiN
硫化物	ZnS, MoS ₂ , WS ₂ , VS ₂
金属	Ru, Pt, W, Ni, Fe, Co, Mn, Cu
复合物	AZO, ITO, ATO, ZnOS, HfSiO _n , LiMnO _x
有机物	FOTS, FDTS, Thiols

操控界面: 专业化 开放化 人性化



通过 GUI 操控界面可以实现参数设置、系统动态监控、数据记录、存储与显示，用户可以自编程。